



808nm 100W 高功率半导体激光器 Bar 条芯片
High Power Diode Laser Bar 808nm 100W

性能参数 Performance Parameters	符号 Symbol	最小值 Min	典型值 Typical	最大值 Max	单位 Unit
Operation					
中心波长 Central Wavelength	λ_c	803	808	813	nm
输出功率 Optical Output power	P_{opt}		100		W
工作模式 Operation Mode	-		QCW		
Geometric Size					
发光单元数 Number of Emitters			30		
发光区宽度 Emitter Width	W		112		μm
发光点周期 Emitter Pitch	P		320		μm
填充因子 Filling Factor	F		35		%
Bar 条长度 Bar Width	B	9900	10000	10100	μm
腔长 Cavity Length	L	1480	1500	1520	μm
厚度 Bar Thickness	D	125	135	145	μm
Electro Optical Data					
阈值电流 Threshold Current	I_{th}		15	17	A
工作电流 Operating Current	I_{op}		98	100	A
工作电压 Operating Voltage	V_{op}		1.8	1.9	V
光谱宽度 Spectral Width(FWHM)	$\Delta\lambda$		4		nm
斜率效率 Slope Efficiency	η	1.15	1.25		W/A
电光转换效率 EO Conversion Efficiency	η_c	53	58		%
快轴发散角 Fast-axis Divergence(FWHM)	$\theta_{\perp}$		35		Deg
慢轴发散角 Slow-axis Divergence(FWHM)	$\theta_{//}$		10		Deg
偏振 Polarization			TM		
工作温度 Operating Temperature			25		$^{\circ}C$

备注：1. 本参数为芯片在 25℃ 条件下测试结果。

Notes: These parameters are the test results of the chip at 25℃.

2. 避免在结露条件下存储和使用，在超过规定温度下工作会影响寿命。

Avoid storage and operation under condensation conditions. Operating above the specified temperature may affect product life span.

3. 超过正常功率范围使用会缩短产品使用寿命。

Operating beyond the rated power range may shorten the product's service life.

